



特許証
(CERTIFICATE OF PATENT)

特許第5846563号
(PATENT NUMBER)

発明の名称
(TITLE OF THE INVENTION)

薄膜トランジスタ、薄膜トランジスタの製造方法および半導体装置

特許権者
(PATENTEE)

茨城県つくば市千現一丁目2番地1

国立研究開発法人物質・材料研究機構

発明者
(INVENTOR)

塚越 一仁
ダルマワン ピーター

その他別紙記載

出願番号
(APPLICATION NUMBER)

特願2014-521410

出願日
(FILING DATE)

平成25年 6月13日(June 13, 2013)

登録日
(REGISTRATION DATE)

平成27年12月 4日(December 4, 2015)

この発明は、特許するものと確定し、特許原簿に登録されたことを証する。
(THIS IS TO CERTIFY THAT THE PATENT IS REGISTERED ON THE REGISTER OF THE JAPAN PATENT OFFICE.)

平成27年12月 4日(December 4, 2015)

特許庁長官
(COMMISSIONER, JAPAN PATENT OFFICE)

伊藤 仁



特許証

(CERTIFICATE OF PATENT)

(続葉 1)

特許第5846563号 (PATENT NUMBER)

特願2014-521410 (APPLICATION NUMBER)

発明者
(INVENTOR)

相川 慎也
生田 目 俊秀
柳沢 佳一

[以下余白]